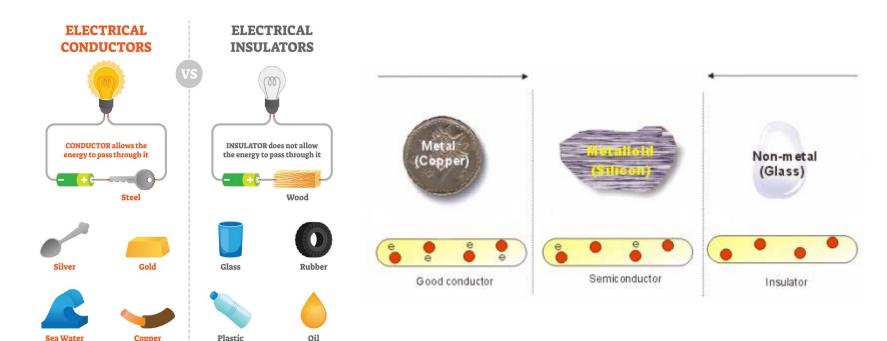


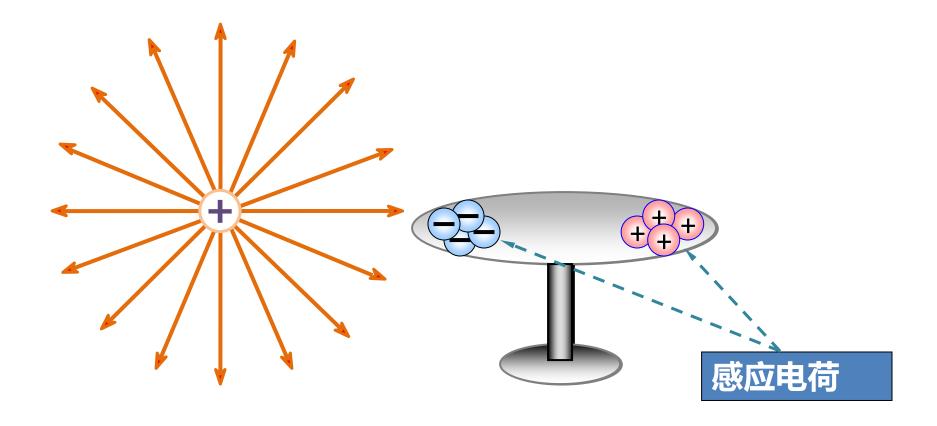
口导体 (conductor): 存在大量可自由移动的电荷;

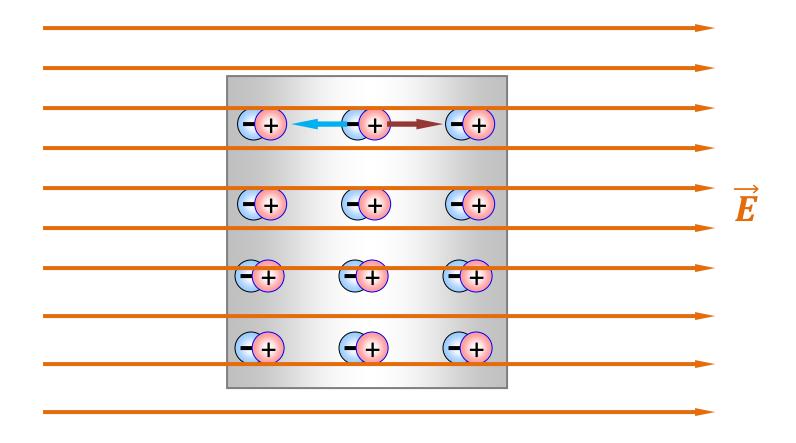
口绝缘体 (dielectric):理论上认为一个自由移动的

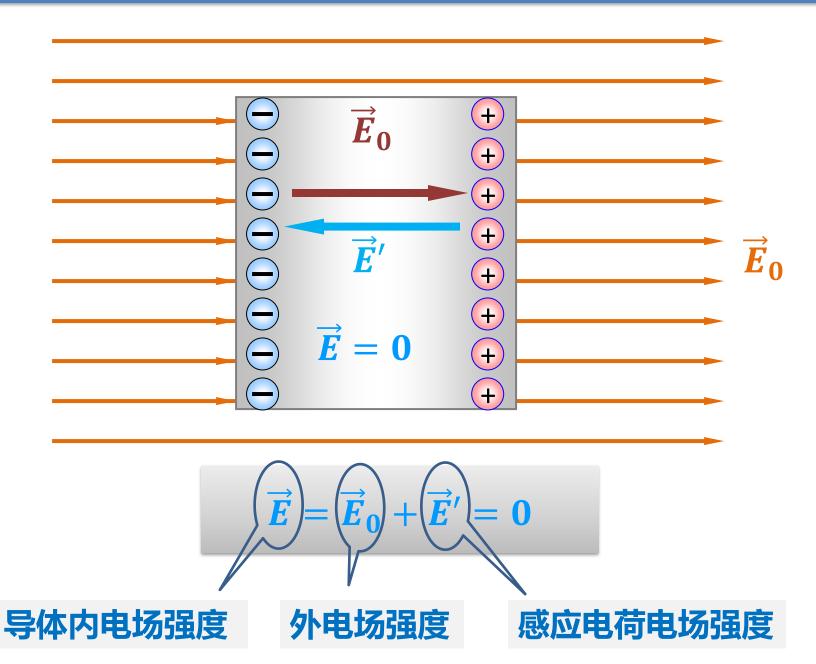
电荷也没有, 也称为电介质;

口半导体 (semiconductor): 介于上述两者之间。









5

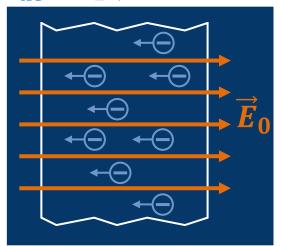
静电感应 (electrostatic induction)

导体内的自由电子在外场作用下发生定向运动, 而使导体上电荷重新分布的现象。

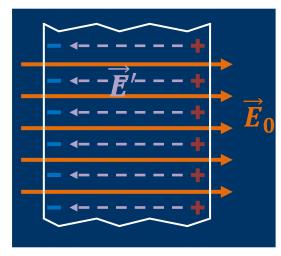
静电平衡 (electrostatic equilibrium)

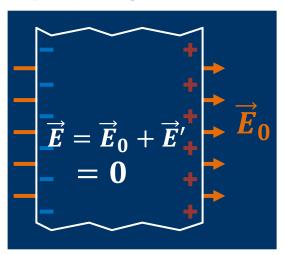
若导体内部和表面无电荷的定向移动,则导体处于静电平衡状态。

● 静电感应



导体静电平衡的微观过程





在外电场的作用下,导体中出现电荷重新分布。

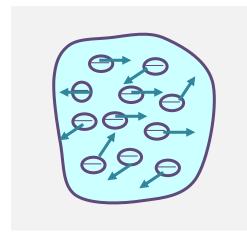
静电平衡 (electrostatic equilibrium)

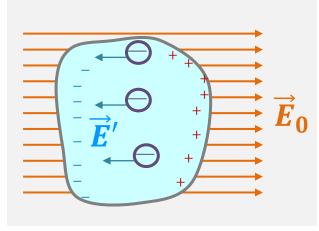
导体内部及表面没有电荷作定向运动的状态。导体上电荷及空间电场分布达到稳定状态。

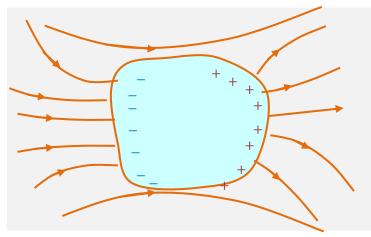
无外场时自由电子无 规运动: "电子气" 在外场 \vec{E}_0 中:

- 1. 无规则热运动;
- 2. 宏观定向运动

导体内电荷重新分布, 出现附加电场 \vec{E}' 直至平衡状态







$$\begin{cases} \vec{E}_{|\uparrow|} = \vec{E}_0 + \vec{E}' = 0 \\ \vec{E}_{\text{*}} = \vec{E}_0 + \vec{E}' \end{cases}$$

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

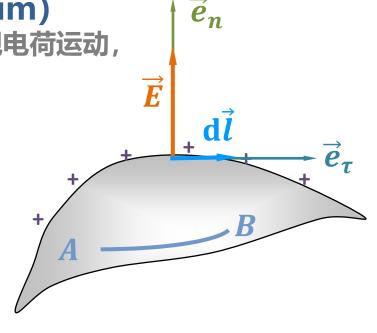
静电平衡 (electrostatic equilibrium)

导体内部和表面上任何一部分都没有宏观电荷运动, 则导体处于静电平衡状态。

◆ 导体静电平衡的条件

$$E_{|\uparrow\rangle} = 0$$

 \vec{E} 表面 \bot **导体表面**



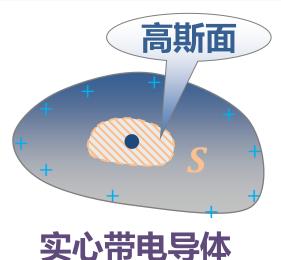
- 静电平衡导体的电场强度
 - 口 导体内部任何一点处的电场强度为零;
 - □ 导体表面处的电场强度的方向,与导体表面垂直。
- 静电平衡导体的电势
 - 即导体是等势体。
 - □导体表面是等势面。

ロ 导体上各点电势相等,
$$: \vec{E} \perp d\vec{l}$$
 $: -\Delta U = \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ 即导体是等势体。
$$U_{ab} = \int_{\vec{E}}^{b} \cdot d\vec{l} = 0$$
 $_{8}$

静电平衡导体上的电荷分布

由导体的静电平衡条件和静电场的基本性质,可以 得出导体上的电荷分布 (有外场而且导体带电)

◆ 导体内无净电荷,电荷只能分布在导体表面



证明:在导体内任取体积元dV

$$\oint_{S} \overrightarrow{E} \cdot d\overrightarrow{S} = 0$$
由高斯定理
$$\sum_{i} q_{i} = \int_{V} (\text{即只有外表面的导体})$$

$$E_{1:1} = 0$$



由于体积元任取 ightharpoonup 导体中各处 ho=0

- 口实心导体,净电荷只分布在导体表面。
- 口 空腔导体,且空腔内无电荷,净电荷只能分布于外表面!
- 口空腔导体,且空腔内有电荷,在内外表面都分布有电荷分布!

口空腔导体,且空腔中无电荷,净电荷只能分布于外表面! (内表面无电荷)

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$
 由高斯定理
$$\sum_{i} q_{i} = 0$$

$$\sum_{i} q_{i} = 0$$





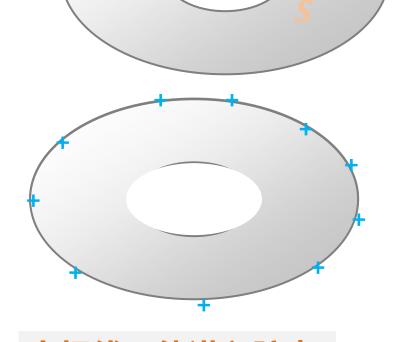
$$U_{AB} = \int_A^B \overrightarrow{E} \cdot d\overrightarrow{l} \neq 0$$

导体是等势体

$$U_{AB} = \int_{A}^{B} \overrightarrow{E} \cdot d\overrightarrow{l} = 0$$

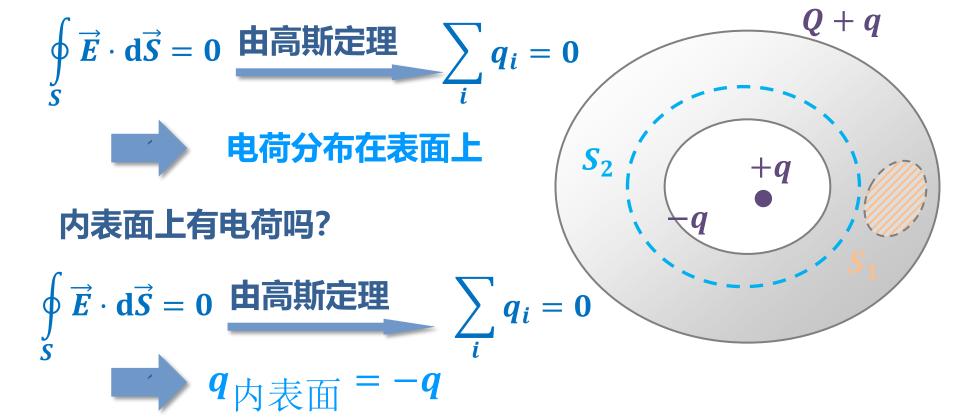


所以导体内表面不带电



电场线不能进入腔内 静电屏蔽。

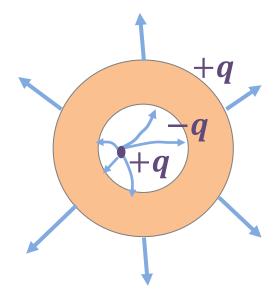
口空腔导体,且空腔中有电荷,在内外表面都分布有电荷分布!



- ✓ 当空腔内有电荷+q时,内表面因静电感应出现等值异号的电荷-q,外表面有感应电荷+q(电荷守恒)。
 - ① 空腔原不带电,腔内电荷q,腔内、外表面电量?
 - ② 空腔原带电Q, 腔内电荷q, 腔内、外表面电量?

口空腔导体,且空腔中有电荷

- ◆空腔内表面感应电荷与腔内电荷等值异号。
- ◆ 导体外表面电荷由导体电荷守恒决定。



腔不接地: 腔内不受腔外电荷影响,

腔外要受腔内电荷影响。

腔接地: 内外电场互不影响。

口 空腔原不带电,腔内电荷q,腔内、外表面电量?

$$q_{\text{内表面}} = -q$$
 $q_{\text{外表面}} = q$

 \square 空腔原带电Q, 腔内电荷q, 腔内、外表面电量?

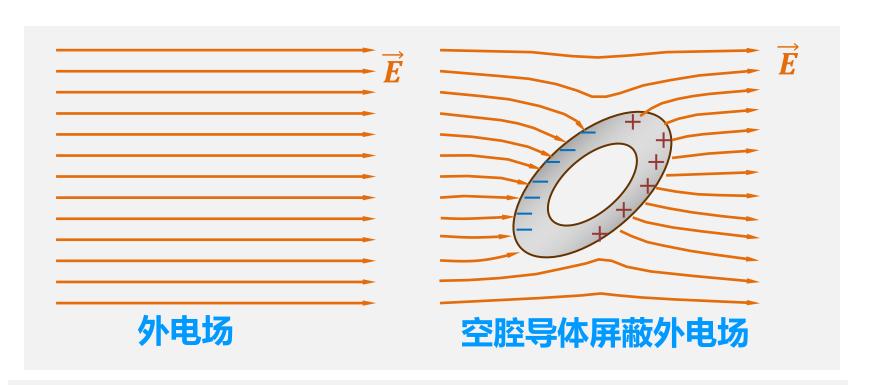
$$q_{\text{內表面}} = -q$$
 $q_{\text{外表面}} = Q + q$

口 空腔能屏蔽腔内电荷q的电场吗? 空腔导体外表面接地

静电屏蔽

- **◆** 屏蔽外电场
- ◆屏蔽腔内电场

$$\vec{E}_{\text{Eph}} = \vec{E}_{\text{Ah}} + \vec{E}_{\text{Ah}} + \vec{E}_{\text{Ah}} + \vec{E}_{\text{Ah}}$$



空腔导体可以屏蔽外电场,使空腔内物体不受外电场影响。 腔内的场与腔外(包括壳的外表面)的电量及分布无关。 这时,整个空腔导体和腔内的电势也必处处相等。

静电屏蔽

屏蔽外电场

◆ 屏蔽腔内电场

接地空腔导体 将使外部空间不受 空腔内的电场影响。

接地导体电势为零

问:空间各部分的 电场强度如何分布?

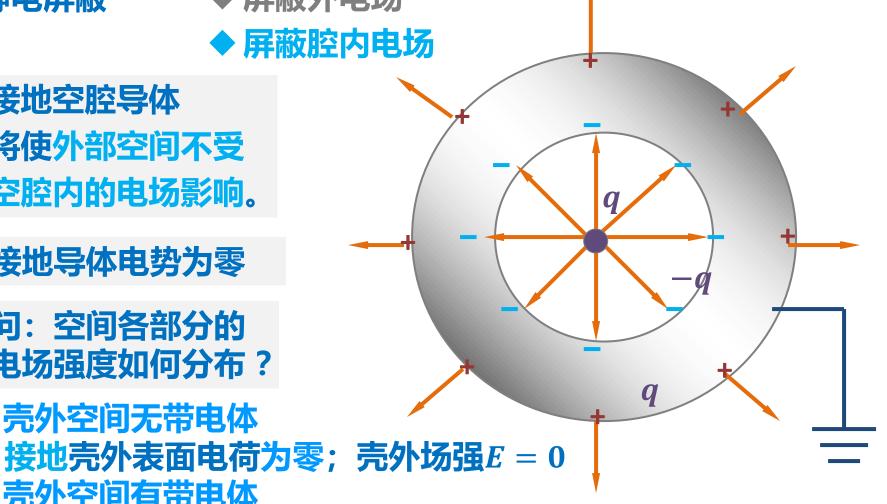
◆ 売外空间无带电体

◆ 売外空间有带电体

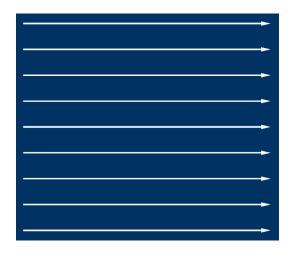
接地壳外表面电荷不为零;

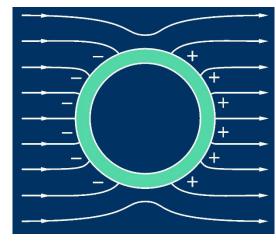
由电动力学可严格证明:壳外场由外部情况决定,

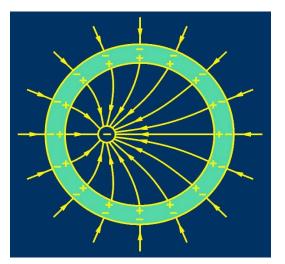
不受壳内电荷的影响。

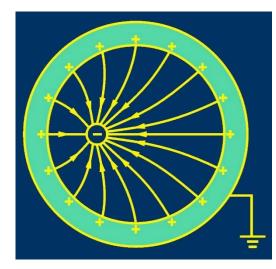


静电屏蔽 (Electrostatic shielding)









腔内场:

只与内部带电量及内部几何 条件 及介质有关 (无论接地 与否)

腔外场: (接地)

只由外部带电量和外部几何 条件及介质决定

腔内电荷q的位置移动

对 $\sigma_{\text{内}}$ 、 $\vec{E}_{\text{内}}$ 分布有影响;

对 $\sigma_{g_{\mid}}$ 、 $\vec{E}_{g_{\mid}}$ 分布无影响。

◆ 高压带电检修

◆ 导体表面电场强度与电荷面密度的关系 静电平衡时导体表面电荷面密度 与表面紧邻处场强成正比

设导体表面电荷面密度为 $\sigma(x,y,z)$

设P是导体外紧靠导体表面的一点,相应的电场强度为

确定电场强度E和电荷密度 σ 的关系:

$$\vec{E}_{\gtrsim}(x,y,z)$$

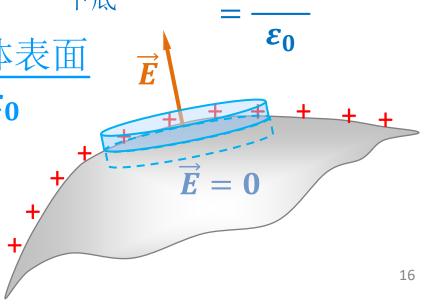
$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{S_{\text{min}}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{S_{\text{min}}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{S_{\text{min}}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = E\Delta S + 0 + 0$$

$$= \frac{\sigma \Delta S}{\varepsilon_{0}}$$



E 表面外附近

E 是总场强, 是空间所有电荷产生的; 是导体表面附近的场强。



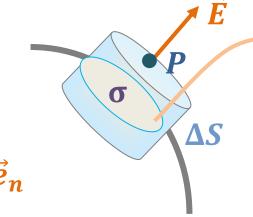
◆ 导体表面电场强度与电荷面密度的关系

静电平衡时导体表面电荷面密度与表面紧邻处场强成正比 $E_{\pm}=-$

 \vec{E} 是总场强,

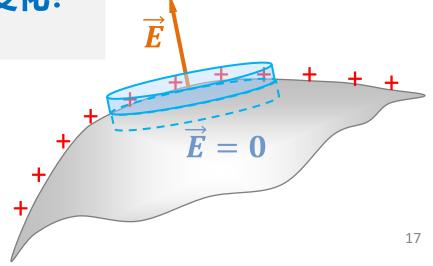
是空间所有电荷产生的;

是导体表面附近的场强。



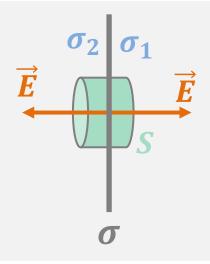
设带电导体表面某点电荷密度为 σ 外侧附近场强 $E = \sigma/\varepsilon_0$,现将另一带电体移近,该点场强是否变化? 公式 $E = \sigma/\varepsilon_0$ 是否仍成立?

导体表面 σ 变化, 外侧附近场强E变化, 而 $E = \sigma/\varepsilon_0$ 仍然成立。



$$E = \sigma/2\varepsilon_0$$

$$E = \sigma/\varepsilon_0$$

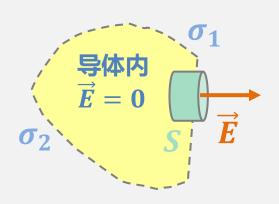


$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 2E\Delta S = \frac{\sigma \Delta S}{\varepsilon_{0}}$$

$$E = \sigma/2\varepsilon_{0}$$



如果计及带电面的厚度, 式中 $\sigma = \sigma_1 + \sigma_2 \approx 2\sigma_1$



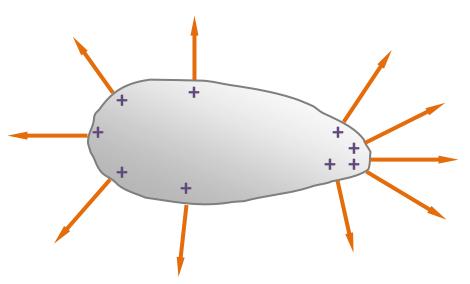
$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = E\Delta S = \frac{\sigma \Delta S}{\varepsilon_{0}}$$

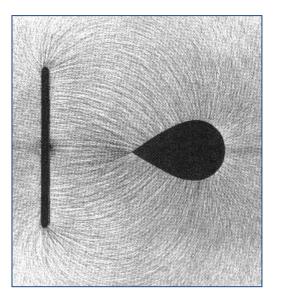


$$E = \sigma/\varepsilon_0$$

这里的产不是一个带电平面产生的, 式中 $\sigma = \sigma_1$,不产生矛盾。

◆ 导体表面电荷分布与导体形状以及周围环境有关。





 $\sigma\downarrow$, $E\downarrow$ $\sigma\uparrow$, $E\uparrow$

带电导体尖端附近电场最强

带电导体尖端附近的电场特别大,可使尖端附近的空气发生电离而成为导体产生放电现象,即尖端放电。

● 尖端放电现象的利与弊

尖端放电会损耗电能,还会干扰精密测量和对通讯产生<mark>危害</mark>。 然而尖端放电也有很广泛的应用。

尖端放电 (Point Discharge)

孤立导体处于静电平衡时,它的表面各处面电荷密度与各点表面的曲率有关,曲率越大的地方(表面凸出的尖锐部分),面电荷密度也大;曲率为负(凹进去)的地方电荷面密度更小。

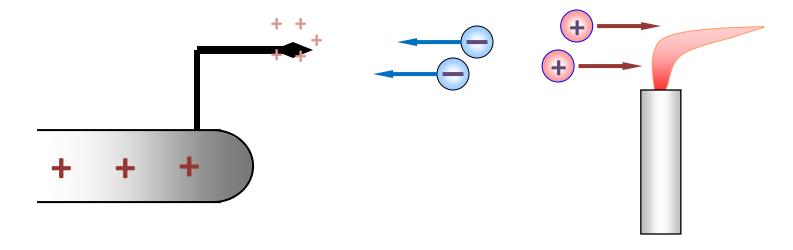
◆高压线光晕

夜间高压输电线上可以看到的"光晕"是由于输电线附近的离子与空气分子碰撞时会使分子处于激发状态,从而长生的光辐射。

◆场离子显微镜 (FIM)

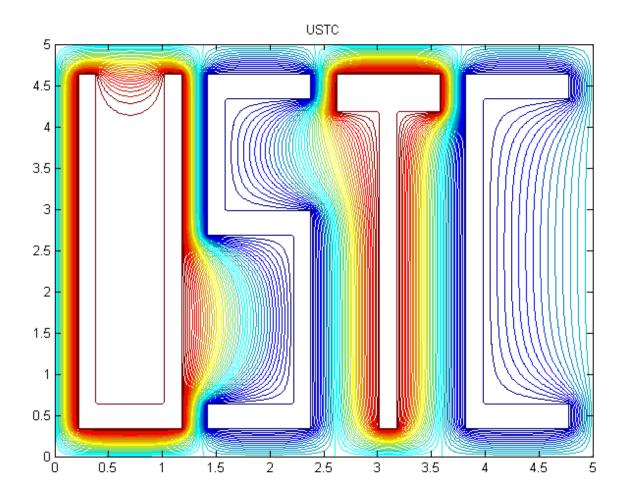
尖端放电 (Point Discharge)

◆电风实验



◆避雷针

尖端放电现象的利用



U、 S、 T、 C 四个字母都是电极, 电压分别为30V、-15V、30V、-15V

计算有导体存在时的 \vec{E} 、U分布

求解思路:

要计算静电平衡时的电场分布,首先要知道其电荷分布。

静电平衡条件

电荷守恒定律



→ **计算**E、*U*分布 (方法同前)

- 口 电势的计算 (两种基本方法)
 - 场强积分法 (由定义求)
 - 叠加法
- 口 场强E分布的基本方法
 - 由点电荷E公式和E叠加原理
 - 由高斯定理求

半径分别为 R_1 和 R_2 ($R_2 > R_1$)的两个相互绝缘的同心导体球壳(忽略球壳的厚度),开始时内球壳带电量为Q,外球壳不带电。然后将外球壳接地,静电平衡后拆去接地导线,将内球壳接地,求静电平衡后内球壳所带电量。

解:外球壳接地,可知外球壳电势为零。 令外球壳带电量为x,可得

$$U = U_1 + U_2 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R_2} + \frac{x}{4\pi\varepsilon_0 R_2} = 0$$

所以外球壳带电量为-Q

接着内球壳接地,可知内球壳电势为零。

令内球壳带电量为y,可得

$$U = U_1' + U_2' = \frac{y}{4\pi\varepsilon_0 R_1} + \frac{-Q}{4\pi\varepsilon_0 R_2} = 0$$

所以内球壳带电量为 $\frac{R_1}{R_2}Q$

 R_2

半径分别为 R_1 和 R_2 ($R_2 > R_1$)的两个同心导体薄球壳,分别带有电荷 Q_1 和 Q_2 ,今将内球壳用细导线与远处半径为r的导体球相联,如图所示,忽略因连接导线在外球壳挖的小洞,导体球原来不带电,试求相联后导体球所带电荷q。

解:设相联后导体球带电q,

取无穷远处为电势零点,

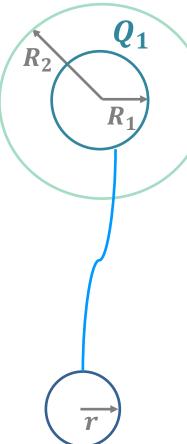
则导体球电势
$$U_0=rac{q}{4\piarepsilon_0 r}$$

内球壳电势
$$U_1 = \frac{Q_1 - q}{4\pi\varepsilon_0 R_1} + \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$$

导体球和内球壳等电势,即

$$\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} = \frac{Q_1 - q}{4\pi\varepsilon_0 R_1} + \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$$

解得
$$q = \frac{r(R_2Q_1 + R_1Q_2)}{R_2(R_1 + r)}$$



两块等面积的金属平板,分别带电荷 q_A 和 q_B ,平板面积均 为S,两板间距为d,且满足面积的线度远大于d。求静电 平衡时两金属板各表面上的电荷面密度。

解:如图示,设4个表面的电荷面密度分别为

 q_1 、 q_2 、 q_3 和 q_4 , 由电荷守恒, 得

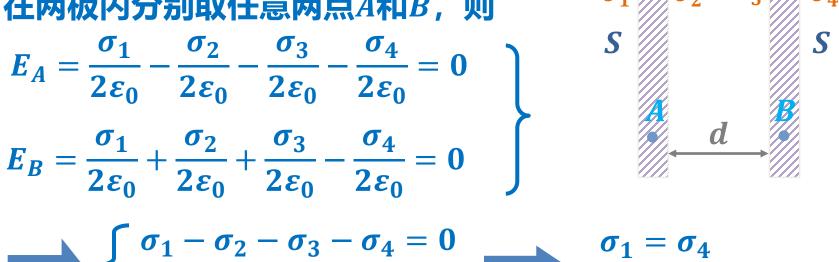
$$\sigma_1 S + \sigma_2 S = q_A$$

 $\sigma_3 S + \sigma_4 S = q_B$

在两板内分别取任意两点A和B,则

$$E_A = \frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\varepsilon_0} = 0$$

$$E_B = \frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\varepsilon_0} = 0$$



$$\begin{cases} \sigma_1 - \sigma_2 - \sigma_3 - \sigma_4 = 0 \\ \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 - \sigma_4 = 0 \end{cases}$$

$$egin{aligned} oldsymbol{\sigma}_1 &= oldsymbol{\sigma}_4 \ oldsymbol{\sigma}_2 &= -oldsymbol{\sigma}_3 \end{aligned}$$

相背面 σ 等大同号,相对面 σ 等大异号。

代入①,得

$$\sigma_1 = \sigma_4 = \frac{q_A + q_B}{2S}$$

$$\sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{q_A - q_B}{2S}$$

igoplus 若 $q_A = -q_B = q$,则 $\sigma_1 = \sigma_4 = 0$

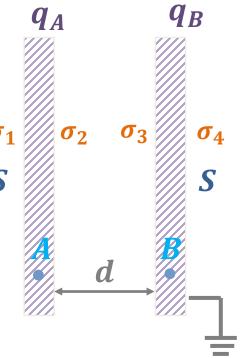
 $\sigma_2 = -\sigma_3 = q/S$

电荷只分布在两板的内侧面,外侧面不带电。

igoplus 若 $q_A = q_B = q$,则 $\sigma_1 = \sigma_4 = q/S$ $\sigma_2 = \sigma_3 = 0$

可见, $A \times B$ 两板的内侧 面带等量异号电荷:两板 的外侧面带等量同号电荷。





电荷只分布在两板的外侧面,内侧面不带电。

◆ 若
$$B$$
板接地,则 $\sigma_1 = \sigma_4 = 0$

$$\sigma_2 = -\sigma_3 = q/S$$

一张面积很大的塑料平面薄膜C,如图所示,经摩擦方式在其表面均匀分布有电荷q,一块带电量为Q的导体平板AB,与薄膜平行放置,设板和薄膜相距为d(忽略板厚),面积均为S(S为单面面积,薄膜只考虑一个面),且d远远小于薄膜板线度,忽略边缘效应,求:

- (1) 导体板两个表面的自由电荷面密度 σ_A 与 σ_B ;
- (2) 空间各处电场强度的分布;
- (3) 导体板与塑料膜之间的电势差。

解: (1) 由电荷守恒可得

$$\sigma_A S + \sigma_B S = Q$$
$$\sigma_C S = Q$$

设水平向右为正方向,由静电平衡时, 导体板内场强为零可得:

$$E_{AB}$$
 $=$ $\frac{\sigma_A}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_B}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_C}{2\varepsilon_0} = 0$

联立上式求解可得:

$$\sigma_A = \frac{Q+q}{2S}$$
 $\sigma_B = \frac{Q-q}{2S}$

28

(2) 在平板AB的左边:

$$\boldsymbol{E}_{1} = -\frac{\sigma_{A}}{2\varepsilon_{0}} - \frac{\sigma_{B}}{2\varepsilon_{0}} - \frac{\sigma_{C}}{2\varepsilon_{0}} = -\frac{Q+q}{2\varepsilon_{0}S}$$

在平板AB与薄膜C之间:

$$\boldsymbol{E}_{2} = \frac{\sigma_{A}}{2\varepsilon_{0}} + \frac{\sigma_{B}}{2\varepsilon_{0}} - \frac{\sigma_{C}}{2\varepsilon_{0}} = \frac{Q-q}{2\varepsilon_{0}S}$$

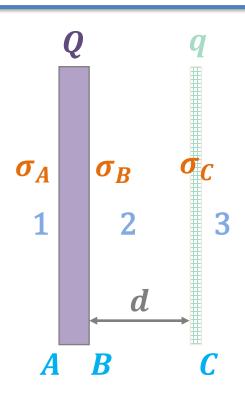
在薄膜C右边:

$$\boldsymbol{E}_{3} = \frac{\sigma_{A}}{2\varepsilon_{0}} + \frac{\sigma_{B}}{2\varepsilon_{0}} + \frac{\sigma_{C}}{2\varepsilon_{0}} = \frac{Q+q}{2\varepsilon_{0}S}$$

(3) 导体板与塑料薄膜之间的电势差

$$U_{BC} = E_{BC}d$$

$$= \left(\frac{\sigma_A}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_B}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_C}{2\varepsilon_0}\right)d = \frac{Q-q}{2\varepsilon_0S}d$$



有一外半径 $R_1 = 10$ cm和内半径 $R_2 = 7$ cm的金属球壳,在球壳内放一半径 $R_3 = 5$ cm的同心金属球,若使球壳和金属球均带有 $q = 10^{-8}$ C的正电荷,求两球体上的电荷如何分布?球心的电势为多少?

解: 根据静电平衡条件求电荷分布 作球形高斯面S₁

$$E_1 = 0 \qquad (r < R_3)$$

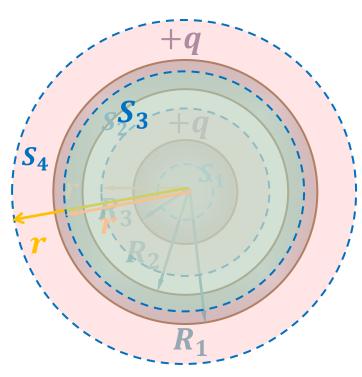
作球形高斯面 S_2

$$\oint_{S_2} \vec{E}_2 \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

$$E_2 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}, \quad R_3 < r < R_2$$

作球形高斯面 S_3

$$E_3 = 0 \quad (R_1 < r < R_2)$$



作球形高斯面 S_4

$$E_4 = \frac{2q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} (R_1 < r)_{30}$$

$$\begin{cases} E_1 = 0 & (r < R_3) \\ E_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (R_3 < r < R_2) \\ E_3 = 0 & (R_1 < r < R_2) \\ E_4 = \frac{2q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (R_1 < r) \end{cases}$$

$$R_{3}$$

$$R_{2}$$

$$R_{1}$$

$$3 \cdot d\vec{l} + \int_{\mathbf{R}}^{\infty} \vec{E}_{4} \cdot d\vec{l}$$

+2q

$$U_{0} = \int_{0}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$= \int_{0}^{R_{3}} \vec{E}_{1} \cdot d\vec{l} + \int_{R_{3}}^{R_{2}} \vec{E}_{2} \cdot d\vec{l} + \int_{R_{2}}^{R_{1}} \vec{E}_{3} \cdot d\vec{l} + \int_{R_{1}}^{\infty} \vec{E}_{4} \cdot d\vec{l}$$

$$U_0 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{R_3} - \frac{1}{R_2} + \frac{2}{R_1} \right) = 2.31 \times 10^3 \text{ V}$$

带电量q、半径 R_1 的导体球A外,有一内半径 R_2 、 外半径 R_3 的同心导体球壳B,求

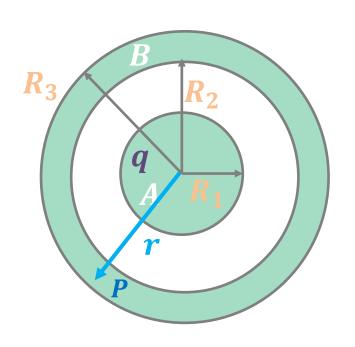
- (1) 外球壳的电荷分布及电势。
- (2) 将B接地再重新绝缘,结果如何?
- (3) 再将A球接地, B电荷分布及电势如何变化?

解: (1)
$$q_{B$$
内表面 = $-q$,
$$q_{B}$$
外表面 = q ,
$$U_{B} = U_{P} = \frac{q}{4\pi\epsilon_{0}r} + \frac{(-q)}{4\pi\epsilon_{0}r} + \frac{q}{4\pi\epsilon_{0}R_{3}}$$
$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_{0}R_{3}}$$



$$U_B = U_{\sharp\sharp\sharp} = 0$$

$$q_{B}$$
内表面 = $-q$, q_{B} 外表面 = 0



带电量q、半径 R_1 的导体球A外,有一内半径 R_2 、外半径 R_3 的同心导体球壳B,求

- (1) 外球壳的电荷分布及电势。
- (2) 将B接地再重新绝缘,结果如何?
- (3) 再将A球接地,B电荷分布及电势如何变化?

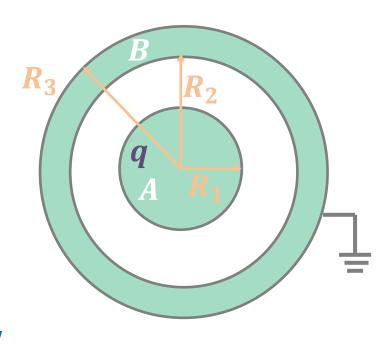
解: (2) 将B接地再重新绝缘,

$$egin{aligned} oldsymbol{U_B} &= oldsymbol{U_{rain}} &= oldsymbol{0} \ oldsymbol{q_{B}}$$
内表面 $egin{aligned} &= -oldsymbol{q_{B}} \end{pmatrix}$, $oldsymbol{q_{B}}$ 外表面 $oldsymbol{0}$

(3) 将A球接地, 设A带电q',则 q_B 内表面 = -q',

$$q_{B}$$
外表面 = $q' - q$,

$$U_A = U_{11} = \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0R_1} + \frac{(-q')}{4\pi\varepsilon_0R_2} + \frac{q'-q}{4\pi\varepsilon_0R_3} = 0$$



带电量q、半径 R_1 的导体球A外,有一内半径 R_2 、 外半径 R_3 的同心导体球壳B,求

- (1) 外球壳的电荷分布及电势。
- (2) 将B接地再重新绝缘,结果如何?
- (3) 再将A球接地, B电荷分布及电势如何变化?

$$q' = \frac{R_1 R_2 q}{R_2 R_3 - R_1 R_3 + R_1 R_2} < q$$

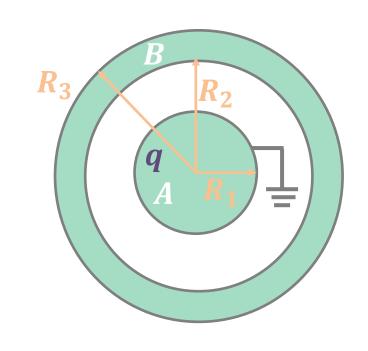
即A导体球所带部分电荷入地。

$$q_{B}$$
 $\neq R_{1}$ $= q' - q$

$$= \frac{(R_{1} - R_{2})R_{3}q}{R_{2}R_{3} - R_{1}R_{3} + R_{1}R_{2}} < 0$$

$$U_{B} = \frac{q_{B} / k \overline{m}}{4\pi \varepsilon_{0} R_{3}}$$

$$= \frac{1}{4\pi \varepsilon_{0}} \frac{(R_{1} - R_{2})q}{R_{2}R_{3} - R_{1}R_{3} + R_{1}R_{2}} < 0$$



 U_B 减小

内半径为R的导体球壳原来不带电,在腔内离球心距离为d (d < R) 处,固定一电量q的点电荷,用导线将球壳接地后再撤去地线,求球心处电势。

解: (1) 接地前的电荷分布。 由静电平衡条件,腔内壁非均匀分布的负电 荷对外效应等效于: 在与q同位置处放置-q。

$$q_{$$
内表面 = $-q$
 $q_{$ 外表面 = q

(2) 外壳接地后电荷分布如何变化?

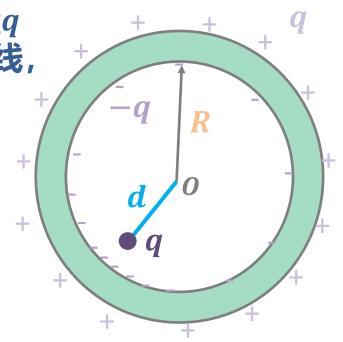
$$U_{\stackrel{\cdot}{\mathbb{R}}} = U_{\stackrel{\cdot}{\mathbb{H}}}$$

$$= U_q + U_{\stackrel{\cdot}{\mathbb{H}}} + U_{\stackrel{\cdot}{\mathbb{H}}}$$

$$= 0$$

$$q_{\stackrel{\cdot}{\mathbb{H}}} = 0$$

导体内表面电荷分布不变 $q_{||_{1}}$ $||_{2}$ $||_{3}$ $||_{4}$ $||_{4}$ $||_{5}$ $||_{5}$ $||_{5}$



(3) 由叠加法求球心处电势。

$$U_{0} = U_{q} + U_{\text{DR}}$$

$$= \frac{q}{4\pi\varepsilon_{0}d} + \frac{-q}{4\pi\varepsilon_{0}R}$$

$$= \frac{q}{4\pi\varepsilon_{0}} \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{R}\right)_{35}$$

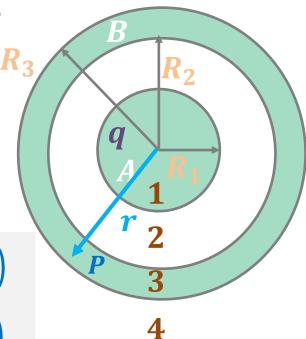
带电量 q_1 、半径 R_1 的导体球A外,有一带电量 q_2 、 内半径 R_2 、外半径 R_3 的同心导体球壳B,求

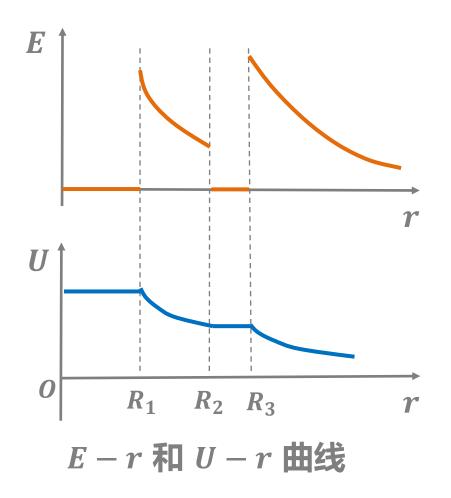
- (1) 图中1, 2, 3, 4 各区域的 \overrightarrow{E} 和U分布, 并画出 E-r 和 U-r 曲线。
- (2) 若将球与球壳用导线连接,情况如何?
- (3) 将外球壳接地,情况如何?

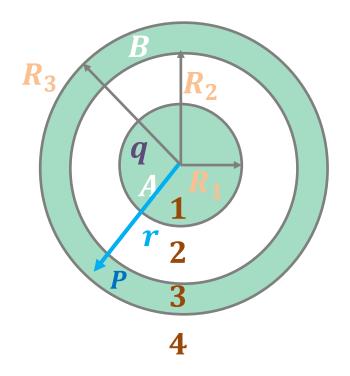
解: (1)
$$q_A = q_1$$
 q_B 内表面 = $-q_1$ q_B 外表面 = $q_1 + q_2$

$$E_1 = 0$$
 $E_2 = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_2^2}$
 $E_3 = 0$
 $E_4 = \frac{q_1 + q_2}{4\pi\epsilon_0 r_2^2}$

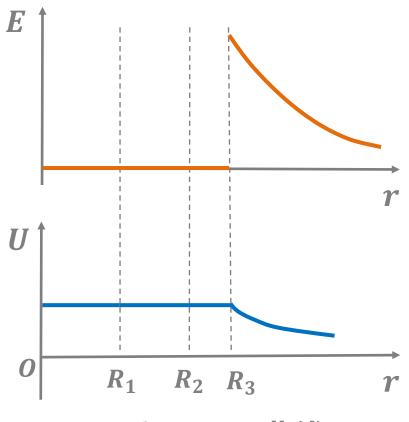
$$\begin{aligned} U_1 &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{q_1}{R_1} - \frac{q_1}{R_2} + \frac{q_1 + q_2}{R_3} \right) \\ U_2 &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{q_1}{r_2} - \frac{q_1}{R_2} + \frac{q_1 + q_2}{R_3} \right) \\ U_3 &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1 + q_2}{R_3} \\ U_4 &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1 + q_2}{r_4} \end{aligned}$$







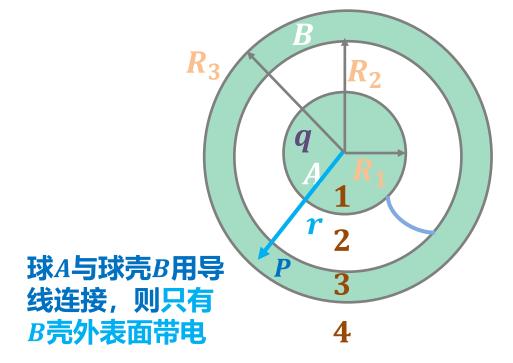
(2) 若将球与球壳用导线连接,情况如何?



E-r 和 U-r 曲线

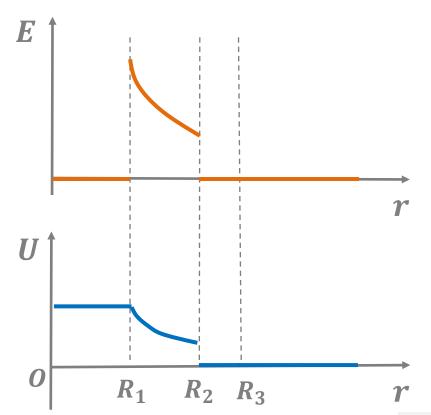
$$E_1 = E_2 = E_3 = 0$$
 $E_4 = \frac{q_1 + q_2}{4\pi\varepsilon_0 r_4^2}$





$$U_1 = U_2 = U_3 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 + q_2}{R_3}$$
 $U_4 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 + q_2}{r_4}$

(3) 若将外球壳接地,情况如何?



解: (3)
$$q_A = q_1$$

$$q_B$$
 q_B q

E-r 和 U-r 曲线

$$E_1 = 0$$
 $E_2 = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_2^2}$
 $E_3 = E_4 = 0$

$$\boldsymbol{U}_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{q_1}{R_1} - \frac{q_1}{R_2} \right)$$

$$U_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{q_1}{r_2} - \frac{q_1}{R_2} \right)$$
 $U_3 = U_4 = 0$

 R_2

将不带电的孤立导体置于某电场中,其上电荷和电势分布如何?

- (A) 净电荷为零, 电势为零
- (B) 净电荷为零, 电势不一定为零
 - (C) 电荷分布在导体外表面, 电势为零
 - (D) 导体上无电荷, 电势不一定为零

下列哪些与尖端放电现象无关?

(A) 避雷针 (B) 电风 (C) 高压线光晕 (D) 高压带电检修

地球表面附近的电场强度约为100 N/C, 方向垂直地面向下。假设地球上的电荷都均匀分布在地表面上, 则地面的电荷面密度 σ 的大小是多少(SI)?($\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}(SI)$)

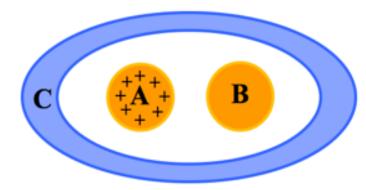
(A)
$$8.85 \times 10^{-10}$$

(B)
$$17.7 \times 10^{-10}$$

(C)
$$4.43 \times 10^{-10}$$

(D) 无法算出

将地球视为导体,由导体表面场强和电荷面密度的关系 $E=rac{\sigma}{arepsilon_0}$, 地面电荷面密度为 $\sigma=arepsilon_0 E=8.85 imes10^{-10} ({
m C/m}^2)$ 如图所示,一封闭的导体壳C内有 两个导体A和B。B、C不带电A带正电,则A、B、C三导体的电势 U_A 、 U_R 、 U_C 的大小关系是

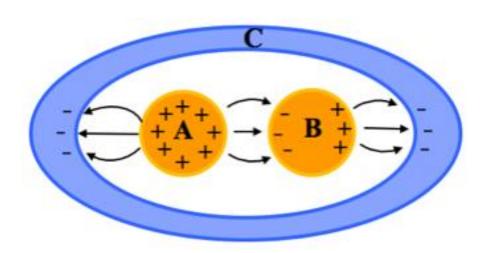


(A)
$$U_B = U_A = U_C$$
 (B) $U_C > U_A = U_B$

(C)
$$U_C > U_B > U_A$$

(B)
$$U_C > U_A = U_B$$

(C)
$$U_C > U_B > U_A$$
 (D) $U_A > U_B > U_C$



由静电感应现象,感应电荷和电力线如图所示, 电力线指向电势降低的方向,因此 $U_A > U_B > U_C$

一个未带电的空腔导体球壳,其内外半径分别为 R_1 和 R_2 。 在腔内球心处固定一电量为+q的点电荷,用导线把球壳接 地后, 再把地线撤去, 选无穷远处为电势零点, 则与球心 相距d ($d < R_1$) 处的P点和球壳的电势各为多少?

(A)
$$0$$
, $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$ (B) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 d}$, 0

(B)
$$\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 d}$$
, 0

(C)
$$\frac{q}{4\pi\varepsilon_0R_1}$$
, $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0R_2}$

(C)
$$\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_1}$$
, $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$ (D) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{R_1}\right)$, 0

由静电感应现象,导体球壳内表面带电-q,外 表面带电+q。

球壳接地后,外球壳电势为零,根据外球壳电 势为零可计算出外球壳电荷为0。

点电荷+q 在P点产生的电势为

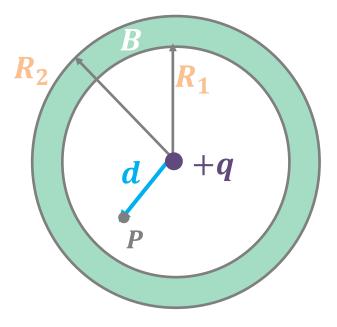
$$U_1 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 d}$$

导体球壳内表面在腔内产生的电势为

$$U_2 = \frac{-q}{4\pi\varepsilon_0 R_1}$$

所以与球心相距d ($d < R_1$) 处的P点的电势为

$$U = U_1 + U_2 = \frac{-q}{4\pi\varepsilon_0 R_1} + \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 d}$$



有一个半径为R的不带电导体球,在球外距离球心r处放置一个点电荷+q,金属球上的感应电荷在球心处产生的电场强度的大小如何?此时导体球的电势是多少?

(A)
$$\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$
, $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$ (B) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$, $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R} + \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$ (C) 0, $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$ (D) 0, $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R} + \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

解:点电荷在球心处激发的电场强度

 $E_q = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$,方向沿着球体半经方向远离球心。

根据静电平衡条件, 球体内电场强度处处为零,

则
$$\overrightarrow{E}_q + \overrightarrow{E}_{\overline{1}\overline{x}} = 0$$
,所以 $\overrightarrow{E}_{\overline{1}\overline{x}} = -\overrightarrow{E}_q$

导体球上的感应电荷在球心处产生的电场强度的大小为 $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ 此时导体球是个等势体,导体球上净电荷为零,故在球心处的电势和为零,所以导体球的电势决定于球外电荷q,即 $U=\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$ 。

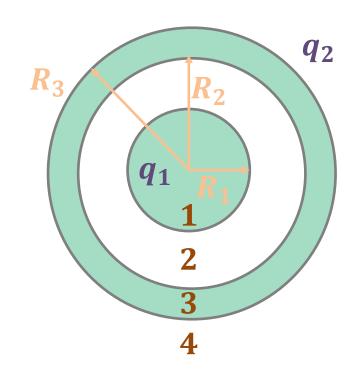
如图,半径为 R_1 的实心导体球带电量为 q_1 ,其外部同心放置一个内外半径分别为 R_2 和 R_3 的球壳,带电量为 q_2 。若将球与球壳用导线连接,空间四个区域的电场是怎么样的?

(A) 0,
$$E = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1^2}$$
, 0, $E = \frac{q_1+q_2}{4\pi\epsilon_0 R_3^2}$

(B) 0, 0, 0,
$$E = \frac{q_1 + q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_3^2}$$

(C) 0,
$$E = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1^2}$$
, 0, $E = \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 R_3^2}$

(D) 0, 0, 0,
$$E = \frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_3^2}$$



当球与球壳用导线连接后,二者构成了一个以区域2为空腔的一个新的球壳,总带电量为 q_1+q_2 。根据静电平衡后导体电荷的分布规律可知,电荷只分布在外表面,即半径为 R_3 的球面上。所以空间1, 2, 3的电场强度均为0,

区域4的电场强度为
$$E=rac{q_1+q_2}{4\pi\varepsilon_0R_3^2}$$

导体的静电感应



静电平衡时 $E_{| | |} = 0$

 $\vec{E}_{$ 表面 $}$ 上 **导体表面**

或:导体是等势体

表面是等势面

电荷只分布在表面

导体表面附近的场强大小遵循 $E=\frac{\sigma_1}{\varepsilon_0}$,方向垂直于导体表面。

静电屏蔽

导体壳不接地,只有外屏蔽效应:外部电场不影响内部,内部电场影响外部。

导体壳接地,有全屏蔽效应:外部、内部电场互不影响。

尖端放电

孤立导体曲率越大(即越尖锐)的地方,电荷越密集。

有导体存在时静电场的分析与计算

电荷守恒 □ 三方法结合 〈 静电平衡条件 高斯定理

□ 常见导体组: 板状导体组 球状导体组

在静电平衡时,

- 若导体空腔内无带电体,导体空腔上的电 荷只能分布在导体空腔的外表面上;
- 若导体空腔内有带电体,导体空腔上的净 电荷及感应电荷只能分布在导体空腔的内、 外表面上,且导体空腔的内表面所带电荷 与腔内带电体的电荷的代数和为零。

- 1. 当一带电体系中的电荷静止不动,从而电场分布不随时间变化时,我们说该带电体系达到了静电平衡。
- 2. 处于静电平衡的均匀导体,其体内的电势处处为零。
- 3. 处于静电平衡的均匀导体,其表面的场强也应该处处为零。
- 4. 处于静电平衡的均匀导体,其表面无净电荷,净电荷只能分布在导体内部。
- 5. 处于静电平衡的空腔导体,其内表面是否带电,可以用静电场的环路定理进行分析。
- 6. 处于静电平衡的空腔导体,其内表面是否带电,可以结合静电平衡条件和高斯定理进行分析。
- 7. 处于静电平衡的空腔导体,其外表面是否带电,可以用电荷守恒定律进行分析。
- 8. 如果空腔导体内部有电荷,它必然会影响导体外的电场。

腔内电荷量发生变化,导体外的电场将随之改变。但如果把空腔导体外表面接地,这样导体与大地等电势,空腔就屏蔽了内电荷对外电场的影响。